查询3DD3150供应商　　捷多邦，专业PCB打样工厂，24小时加急出货

2SC3150(3DD3150)　　硅 NPN 半导体三极管/SILICON NPN TRANSISTOR

用途:用于开关电源。

Purpose: Switching regulator applications.

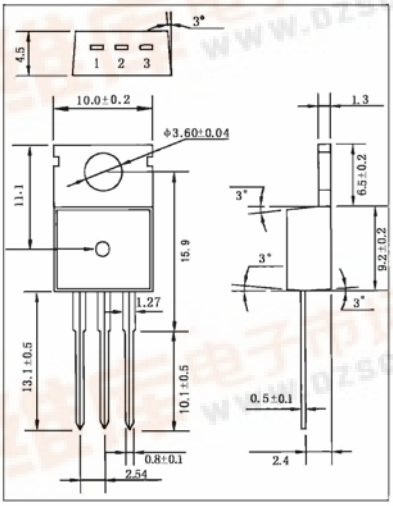
特点:击穿电压高，开关速度快，宽阔的安全区。

Features: High V_{CEO}, high speed switching, wide ASO.

极限参数/Absolute maximum ratings(Ta=25℃)

参数符号 Symbol	数值 Rating	单位 Unit
V_{CBO}	900	V
V_{CEO}	800	V
V_{EBO}	7.0	V
I_C	3.0	A
I_{CP}	10	A
I_B	1.5	A
P_C	2.0	W
P_C(Tc=25℃)	50	W
T_j	150	℃
T_{stg}	-55～150	℃

TO-220　　单位 :mm



引脚：1 B　2 C　3 E

电性能参数/Electrical characteristics(Ta=25℃)

参数符号 Symbol	测试条件 Test condition		数值 Rating 最小值 Min	典型值 Typ	最大值 Max	单位 Unit
V_{CBO}	I_C=1.0mA	I_E=0	900			V
V_{CEO}	I_C=5.0mA	I_B=0	800			V
V_{EBO}	I_E=1.0mA	I_C=0	7.0			V
I_{CBO}	V_{CB}=800V	I_E=0			10	μA
I_{EBO}	V_{EB}=5.0V	I_C=0			10	μA
$h_{FE(1)}$	V_{CE}=5.0V	I_C=0.2A	10		40	
$h_{FE(2)}$	V_{CE}=5.0V	I_C=0.5A	8			
$V_{CE(sat)}$	I_C=1.5A	I_B=0.3A			2.0	V
$V_{BE(sat)}$	I_C=1.5A	I_B=0.3A			1.5	V
f_T	V_{CE}=10V	I_C=0.2A		15		MHz
C_{ob}	V_{CB}=10V	f=1.0MHz		60		pF
ton	$5I_{B1}=-2.5I_{B2}=I_C=2.0A$ R_L=200Ω，V_{CC}=400V				1.0	μS
tstg					3.0	μS
toff					0.7	μS

$h_{FE(1)}$分档/ $h_{FE(1)}$ classifications:　K:10～20　L:15～30　M:20～40

找PDF 维库一下 pdf.dzsc.com